JP-hei-2-49140-U (cited reference 1)
Publication date in Japan: April 5, 1990

#### A considerable part of the description :

Semiconductor pellets 1 are mounted on a substrate 2 of epoxy resin through solder, and the substrate 2 is adhered through an adhesive 4 onto an island portion 31 of copper. As shown in figs. 2 and 3, the island portion 31 has suspension pins connected to external bridge bands 10 and recesses 31a, external leads 72 are received by the recesses 31a, and ends 72a of the external leads 72 are adhered to the island portion 31 of the substrate 2 through the adhesive 4 so that the ends 72a, the substrate 2 and the island potion 31 form a joint. Electrodes (not shown) of the semiconductor pellets 1 and an electrically conductive pattern 5 on the substrate 2 are connected by wires 6, and the electrically conductive pattern 5, the external leads 72 and the external leads 71 are connected by the wires 6 before being molded with resin. Parts of suspension pins 32 projecting from a mold package are cut off.

19 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平2-49140

®Int. Cl. <sup>5</sup>

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月5日

H 01 L 23/50 25/04

25/18

7735-5F

7638-5F H 01 L 25/04

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称

半導体装置

②実 願 昭63-127743

22出 願 昭63(1988) 9月29日

②考 案 者 大 江 直 彦

Z

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社

⑪出 願 人 関西日本電気株式会社 滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号

#### 明 細 書

- 考案の名称
   半導体装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) 複数の半導体ペレットがマウントされたプリント基板をアイランド部に貼り合わせ、外部導出リードと上記プリント基板の導電パターンとをワイヤボンディングした後樹脂モールドパッケージングしてなる半導体装置において、

上記アイランド部に外部導出リードに対応する 凹部を形成し、該凹部に上記外部導出リードの延 設された一端を進入させてアイランド部およびプ リント基板の少なくとも一方と近接かつ絶縁して 接着したことを特徴とする半導体装置。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は、ハイブリッドIC等の半導体装置に 関し特にリード構造の改良に関する。

[従来の技術]

ř

ハイプリッドICは、回路集積度が増す傾向が

大で、最近では多数の半導体ペレットがマウントされた、いわゆるハイブリッド1Cが出現している。す構造となっている。即ち、複数の半導体ペセット1、1 …をプリント基板 2 に半田(図示すせつントを力して、該プリント基板 2 を行いるとは、変元というでは、変元によって、変元を行って、変元を行って、変元を行って、変元を行って、変元を行って、変元をでは、変元をでは、ないがでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、はいる。

上記のハイブリッドICでは、プリント基板 2 が主にガラスエポキシ樹脂で形成されているため、銅板等の金属で製作され、接着剤 4 によってプリント基板 2 へ貼付けるリードフレームのアイランド部 3 とは、熱膨張係数が異なっている。そのた



め、樹脂モールドパッケージ8を形成するモールド樹脂による加熱・冷却によって、両者間に大きな熱歪が生じ、アイランド部3に変形や反りを招いてる。そこで、変形や反りの影響を緩和するため、プリント基板2と接着剤4で貼り合わせるアイランド部3は、外部の橋絡条帯(図示せず)と繋がった複数本(図では4本)の吊りピン9、9…で支持させれおり、この状態で、樹脂モールドパッケージングしている。そして、樹脂モールドパッケージとから突出した半導体装置では不要な吊りピン9、9…はパンチ等で打ち抜いて切除している。

#### [考案が解決しようとする課題]

しかしながら樹脂モールドパッケージ8後に不要な吊りピン9,9…を打ち抜いて切除する際に生じる衝撃によって、樹脂モールドパッケージ8と吊りピン9,9…との界面部分に亀裂やクラック等が生じ易くなっている。そのため、耐湿性が低下して亀裂やクラックから水分等が界面をつたって侵入し、内部のワイヤ6,6…が錆びて断線



したり、ワイヤ 6 , 6 …を伝って侵入した水分等がプリント基板 2 上の導電パターン 5 . 5 … に影響を与え、ハイブリッド I C の耐圧や電気的特性の低下につながるといった大きな問題があった。

#### [課題を解決するための手段]

上記問題を解決するために、本考案の半導体装置は、複数の半導体ペレットがマウントされたプリント基板をアイランド部に貼り合わせ、外部をフリント基板の導電パターンとをフリントを提出したでは、上記アイランド部に外部導出リードの延設された一端を進入させてアイランド部およびプリント基板の少なくとも一方と近接かつ絶縁して接着したことを特徴とする。

#### [作用]

上記構成の半導体装置では、アイランド部に形成された複数の凹部のそれぞれに、外部導出リードの延設された一端を進入させ、複数の半導体ペ



レットがマウントされたプリント基板を、アイラ ンド部上に接着すると、各外部導出リードはアイ ランド部の凹部とプリント基板とに接着されて一 体となる。そして外部導出リードと上記プリント 基板の導電パターンとをワイヤボンディングした 後樹脂モールドパッケージングすると、アイラン ド部の凹部で接着一体となった外部導出リードが、 該アイランド部と橋絡条帯とを繋ぐ吊りピンと同 じ役目つまり、樹脂モールド時の加熱・冷却によ るアイランド部の熱歪による変形の悪影響を回避 するとともに、アイランド部は橋絡条帯と衝撃緩 和可能な関節接続とすることができるので、樹脂 モールドパッケージング後に吊りピンを打ち抜く ときの衝撃も少なくなり、吊りピンと樹脂モール ドパッケージ界面等に亀裂やクラックが生じ難く なる。



#### [実施例]

以下、図面を参照して本考案の一実施例を説明する。

第1図は本考案の一実施例にかかる半導体装置

を示す一部破断斜視図、第2図は第1図の半導体 装置のI-I断面図、第3図は同実施例で使用さ れるアイランド部と外部導出リードの斜視図であ る。図に示す半導体装置は、例えば、複数の半導 体ペレット1,1…よりなるハイブリッドICで あり、複数の半導体ペレット1、1…が半田(図 示せず)を介して、例えばエポキシ樹脂で製作さ れるプリント基板2にマウントされ、該プリント 基板2を、例えば、銅板等の金属で製作されるア イランド部31上に接着剤4を介して貼り合わせ ている。上記アイランド部31は、第2図及び第 3図に示すように、外部の橋絡条帯10に繋がる 2本の吊りピン32, 32と、矩形状に切除され た凹部 3 1 a 、 3 1 a … が複数箇所(図では 4 箇 所)に設けられており、該凹部31a, 31a… には、一端72aが延設された外部導出リード7 2, 72…を進入させ、該外部導出リード72. 7 2 … の一端 7 2 a , 7 2 a … とプリント基板 2 とアイランド部31とが接着剤4によって接着さ れて一体となっている。つまり、一端12a.1



2 a … とプリント基板 2 およびアイランド部 3 1 とは、いわゆる関節接続となっている。そして、半導体ペレット 1 , 1 … の電極 (図示せず)とプリント基板 2 上に形成された導電パターン 5 , 5 … とをワイヤ 6 , 6 … によってボンディングすると共に、上記導電パターン 5 , 5 … とでアイランド部 3 1 a … に一端 7 2 a , 7 2 a を進入させて接着一体となった外部導出リード 7 1 , 7 1 … とを同様にワイヤ 6 , 6 … によってボンディングし、その後樹脂モールドパッケージ 8 より突出する上記吊りピン 3 2 はパンチ (図示せず)等によって切断除去されている。



上記半導体装置では、アイランド部31に形成された凹部31a,31a…に進入させた外部導出リード72,72…は、接着剤4によるプリント基板2とアイランド部31との接着工程で同時に接着させることができる。このとき、外部導出

リード 7 2 、 7 2 … は、凹部 3 1 a , 3 1 a … に 対し接着剤4によって絶縁状態となるが、機械的 にはある程度耐衝撃性を持った連結状態となって 強度も確実に得られる。従って、上記アイランド 部 3 1 と橋絡条帯 1 0 を繋ぐ吊りピン 3 2, 3 2 と同様の役目、つまり、該外部導出リード72, 72…も樹脂モールドパッケージ8におけるモー ルド樹脂の加熱冷却によるプリント基板2とアイ ランド部31との熱膨張係数差によってアイラン ド部31の変形や反りの悪影響を回避するととも に、樹脂モールドパッケージング後に切断除去さ れる吊りピン32,32は2本と少ないので、該 吊りピン32,32を切断するときの衝撃も少な く、樹脂モールドパッケージ8との界面に生じる 亀裂やクラック等の発生も殆どなくなる。従って、 耐湿性が低下して亀裂やクラック等から水分等が 侵入し、内部のワイヤ6、6…が腐食して断線し たり、ワイヤ6、6…を伝って侵入した水分等が プリント基板 2 上の導電パターン 5 … に影響を与 え、ハイブリッドICの耐圧性や電気的特性の低



下につながる心配はなくなる。また、外部導出リード72,72…の一端72a,72a…がアイランド部31の凹部31a,31a…にまで延びているので、この外部導出リード72,72…と樹脂モールドパッケージ8との接合面積も広くなってリード引き強度も充分に確保できる。

No.

次に、第4図に本考案の他の実施例の半導体装置に使用されるアイランド部33と外部導出リード73の斜視図を示す。該アイランド部33には、上記アイランド部31より幅の狭い凹部33a...33a…と対応する外部導出リード73.73…は、一端73a,73…が上記でが狭く成形されている。このようなアイランド部33の凹部33a...。33a…に、外部導出リード73,73…の一端73a...。2と接着別4を介して接着一体として33との連結強度は充分であり、橋絡条帯10に繋が

る吊りピン32、32と同じ役目を果たし、樹脂 モールドパッケージにおけるアイランド部33の 変形や反りの悪影響回避とともに、吊りピン2. 32の打ち抜きに対する耐衝撃性をも兼ね備える。 ここで、上記半導体装置に使用されたアイラン ド部31、33はいずれも2本の吊りピン32、 32が橋絡条帯10に繋がって成形されているが、 該橋絡条帯10との連結強度が充分であれば、こ の吊りピン32は少なくとも1本あればよい。ま た、アイランド部31、33に凹設される凹部3 1a, 33a…の数を調節して吊りピン32と同 じ役目をする外部導出リード72,73…の本数 を確保してアイランド部31、33の樹脂モール ドパッケージによる変形や反りを防止すればよい。 尚、第2図及び第3図に示すように、アイランド 部31と外部導出リード71、72及びアイラン ド部33と外部導出リード71,73とは、各々 一体で打ち抜くことができるので、上記アイラン ド部31, 33の凹部31a, 33aの凹設箇所 や形状、該凹部31a、33aに対応して進入さ



れる外部導出リード71,72の一端71a,7 2 a 等の形状変更も打ち抜き作業時に併行すれば よく、作業性や工数面での問題もない。

また、プリント基板2の導電パターン5のうち、アイランド部31、33の凹部31a、33aに進入された外部導出リード72、73とワイヤ6によってワイヤボンディングする代わりに、該外部導出リード72、73の延設された一端72a、73aに対応する導電パターン5のプリント基板2にスルーホールを穿孔し、該スルーホールに半田を流し込んで、外部導出リード71、73と導電パターン5とを接続することもできる。このようにすれば、導電パターン5と外部導出リード71、73とのワイヤボンディング工程が省略できる。

#### [考案の効果]

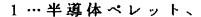
以上の説明から明かなように、本考案の半導体 装置は、外部導出リードが吊りピンの役目をなし、 アイランド部に繋がる吊りピン数を必要最小限に できる。従って、吊りピンの切除に起因する樹脂



モールドパッケージとの界面に生じていた亀裂や クラック等は少なくなり、半導体装置の耐湿性、 耐圧、電気的特性等に悪影響を与えず信頼性が一 段と向上する。また、外部導出リードと樹脂モー ルドパッケージとの接合面積も広くなり、リード 引き抜き強度も充分に確保できるといった効果を 奏する。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例にかかる半導体装置の一部破断斜視図、第2図は第1図の半導体装置の1-1断面図、第3図は同実施例に使用されるアイランド部と外部導出リードの斜視図、第4図は本考案の他の実施例の半導体装置に使用されるアイランド部と外部導出リードの斜視図、第5図は従来の半導体装置の一部破断斜視図である。



2 … プリント基板、

5…導電パターン、

8…樹脂モールドパッケージ、

31, 33…アイランド部、



3 1 a, 3 3 a ··· 凹部、

71…外部導出リード、

72,73…一端を延設した外部導出リード、

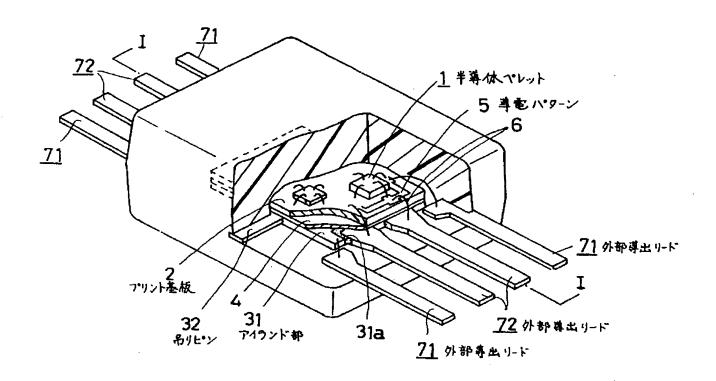
7 2 a , 7 3 a ··· 一端。

実用新案登録出願人 関西日本電気株式会社

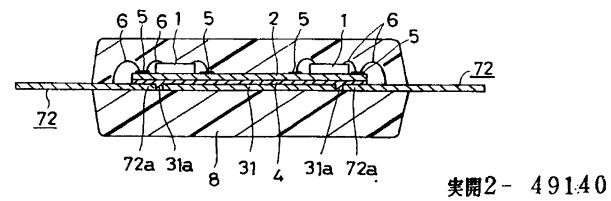




### 第1図



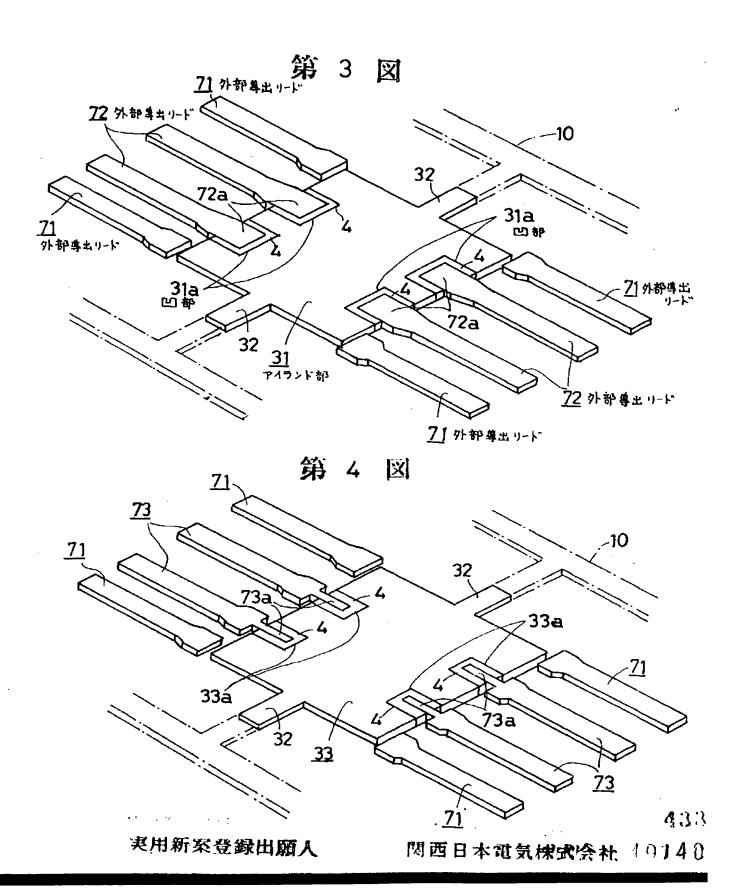
# 第 2 図



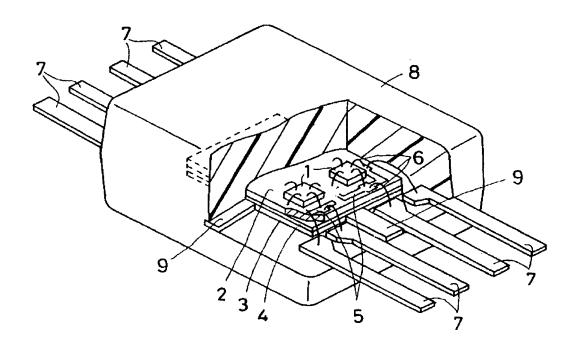
**夹用新案登録出願人** 

関西日本電気株式会社

432



# 第 5 図



実際2- 49140 関西日本電気株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| BLACK BORDERS   |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                                 |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING   |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                                  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES   |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                                  |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS  |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                                   |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY                 |
| OTHER:  |

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.